

RFMD 보도자료

본사 문의:

RF Micro Devices Inc.
Brian K. Cockman, Public Relations Specialist
7628 Thorndike Road
Greensboro, NC 27409-9421, USA
Tel: +1 (336) 678-8945
bcockman@rfmd.com



RFMD, 메이저 군수장비업체와 최초의 GaN 파워앰프 공급 계약 체결 RFMD 사상 최초의 GaN 파워앰프 수주

RFMD의 GaN 사업 전략 요약:

- RFMD의 시장 및 고객층 다양화
- RFMD의 화합물 반도체 및 파워앰프 분야에서의 전문성 활용
- RFMD의 TAM(Total Addressable Market)을 \$1B 규모의 고전력 반도체 시장까지 확대

2007년 1월 29일 노스캘리포니아 그린스보로 – 세계적인 무선 통신 애플리케이션용 고성능 무선 시스템 및 솔루션 전문 개발 업체인 RFMD(RF Micro Devices, Inc., NASDAQ: RFMD)는 오늘, 메이저 군수 장비업체로부터 처음으로 RFMD의 GaN(gallium nitride) HEMT(high electron mobility transistor) 공정 기술을 사용하는 신제품에 대한 구매 주문을 받았다고 밝혔다. RFMD의 GaN 기술은 매우 광범위한 마이크로파 주파수 대역에서 동작이 가능하여, 다중 대역 및 광대역 애플리케이션에 매우 이상적이다. RFMD가 GaN 파워앰프에 대한 구매 주문을 받기는 이번이 처음이다.

이번 주문은 RFMD의 RF3825 파워 IC 광대역 파워앰프에 대한 것으로, 이 제품은 200MHz ~ 1.9GHz 주파수 대역에서의 서비스 기능을 지원하는 15W 성능의 디바이스이다. RF3825는 군사용 통신을 위한 SDR(software defined radio) 대역폭을 크게 강화해 준다.

RFMD의 사장겸 CEO인 밥 브러지워스(Bob Bruggeworth)는 “우리의 고유한 GaN 공정기술 제품에 대한 이 최초의 구매 주문은 RFMD에 있어서는 고객 및 시장 다양화와 관련한 커다란 진전을 의미한다. 이 새로운 시장의 개척으로 인해 누릴 수 있는 복합적인 수익 창출 기회는 약 10억달러 규모에 달하며, 이는 누적 수익과 마진 그리고 매출 면에서 매우 의미 있는 신성장 동력을 RFMD에 제공해 줄 것으로 기대된다. 우리의 GaN 개발을 위해 미국 정부가 연구개발비용의 일부를 지원했으며, 이번 발표는 GaN의 기술적

성과가 빛을 발할 수 있는 많은 군수 애플리케이션 중 하나일 뿐이다. 또한 GaN 기술은 군수용 애플리케이션을 비롯하여, 일반 모바일 통신, 와이맥스 그리고 WCDMA 기지국 등의 분야에도 적용될 수 있다. RFMD는 GaN 분야에서 명실상부하게 확고한 우위를 다지고 있으며, 이는 우리가 보유한 업계 선도적인 화합물 반도체 제조 및 설계 역량에 의해 뒷받침 되고 있다”고 말했다.

RFMD의 CTO인 빌 프랫(Bill Pratt)은 “GaN은 매우 독창적인 전기적 특성을 갖고 있어서 고전력, 고성능 애플리케이션에 매우 이상적인 기술이다. GaN은 실리콘 LDMOS 기술보다 훨씬 뛰어난 효율 및 전력 밀도를 갖고 있으며, 이러한 특성은 많은 시장 영역에서 GaN의 기본적인 경쟁력이 되고 있다. 이 외에도 GaN 기술은 매우 광범위한 주파수 대역에서 동작할 수 있다. GaN은 WCDMA, 와이맥스, 군사용 전파교란기(jammer) 그리고 그 밖의 다른 단일 기기 시장에서 요구하는 다중 대역 분야에서, 예컨대 LDMOS 같은 경쟁적인 공정 기술들에 의해 요구되는 다중 기기에 비해 비용 효율적으로 이용이 가능하다”고 밝혔다.

RFMD는 노스캘리포니아의 그린스보로에 위치한 양산 제조 시설에서 자사의 독자적인 GaN 제품을 생산하고 있으며, 파워 앰프 분야에서의 리더십뿐만 아니라 화합물 반도체 분야에서의 전문성을 극대화한다. RFMD는 AlGaAs HBT 및 GaAs pHEMT 분야의 세계 일류 제조업체이다. 또한 InGaP HBT의 선도적인 기업일 뿐만 아니라 최근에는 자사의 2세대 InGaP HBT 공정도 발표한 바 있다. RFMD는 전세계 휴대폰용 파워앰프 분야도 선도하고 있다. RFMD는 지난 2000년에 GaN 기술을 상용화하기 시작했으며, 2007년 상반기에 이 기술을 적용한 첫번째 제품을 출시할 예정이다.

RFMD는 2007년에 GaN과 관련한 첨단 기술을 발표하게 될 예정이다. 여기에는 높은 선형성과 넓은 대역폭, 그리고 최대 200W에 달하는 출력 성능을 특징으로 하는 고전력 앰프(HPA)의 출시 소식도 포함되어 있다.

RFMD 회사소개

RFMD는 세계적인 무선 통신 애플리케이션용 고성능 무선 시스템 및 솔루션 개발 업체이다. RFMD는 전세계 무선 시장에 필요한 파워앰프, 전송 모듈, 휴대폰 트랜시버 및 SOC 솔루션을 제공하고 있으며, 이들 제품은 연결성이 특히 강화된 것이 특징으로, 기존 및 차세대 휴대폰 단말기, 휴대폰 기지국, WLAN, WPAN 및 GPS에서의 고급 기능을 지원한다. 다양한 최첨단 반도체 기술과 우수한 RF 시스템 전문 기술력을 갖춘 RFMD는 시장 요구사항을 충족시킬 수 있는 고급 무선 기능을 제공하고자 하는 세계 유수의 모바일기기 제조업체들에게 가장 많이 선호되고 있는 업체이다.

미국 노스캐롤라이나 그린스보로에 위치한 RFMD는 ISO 9001 및 ISO 14001 인증업체로, 전세계에 엔지니어링, 설계, 판매 및 서비스 관련 시설을 갖추고 있다. RFMD는 NASDAQ 시장에서 RFMD 기호로 거래되고 있다. 더 자세한 정보는 홈페이지 참조 www.rfmd.com.

참고 (면책규정)

본 보도자료는 1995년에 제정된 증권인사소송법 조항의 면책규정 정의 내에서 전망적 진술을 포함하고 있다. 이러한 전망적 진술은 회사 계획에 대한 언급, 목적 및 주장 및 분쟁 등을 포함할 수 있으며, 과거의 사실이 아니다. 일반적으로 '~일지 모른다', '~할 것이다', '~해야 한다', '~할 수 있다', '~기대하다', '~계획하다', '~예견하다', '~믿는다', '~추정하다', '~예측하다', '잠재력 있는', '~계속하다'를 비롯해 이와 비슷한 표현들이 이와 같은 진술에 포함되며, 일부 전망적 진술은 다르게 표현되기도 한다. 여기에 포함된 전망적 진술은 경영진의 현 상황에 있어서의 판단이나 기대를 나타내는 것일 뿐이며, 사실적 결과, 사건, 성과는 이렇게 표현되거나 내포하고 있는 전망적 진술과는 실제로 다를 수도 있다. RFMD는 연방증권법에 의해 필요한 경우에 외에는 언급된 전망적 진술에 대해 어떠한 업데이트를 하거나 관련 진술에 대한 변경 결과를 공식적으로 발표할 의무를 지지 않는다. RFMD의 사업은 다음과 같이 많은 위험성과 불확실성을 가지고 있다: 분기별 사업운영 결과 변화, 무선 시장의 발전 및 성장률, 웨이퍼 제조시설 운영/분자빔 에피택시 시설/어셈블리조립 시설/테스트 및 테이프앤릴 시설과 관련된 위험요소, 숙련된 인력 고용/유지 및 임원 계발, 생산 수율의 변화, 혁신적 기술 구현을 통한 비용 절감 및 총 수익 향상 능력, 신제품 출시 능력, 제품 수요 변화에 탄력적으로 대응하기 위한 적기의 생산량 조절 능력, 제한적인 고객 및 써드파티에 대한 의존도. 이러한 위험과 불확실성은 가장 최근에 美연방증권거래위원회에 제출된 RFMD의 10-K 애뉴얼 리포트에 자세히 기술되어 있다. 그러나 이는 전망에 불과하며, 실제로는 표시된 내용과는 전혀 다른 결과가 발생할 수도 있다.

RF MICRO DEVICES® 및 RFMD®는 RFMD, LLC.의 상표이다.
기타 모든 상호, 상표 및 등록상표는 해당소유자의 자산이다.

###